

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-054358

(43)Date of publication of application : 26.02.1999

(51)Int.Cl.

H01G 4/12

(21)Application number : 09-205022

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 30.07.1997

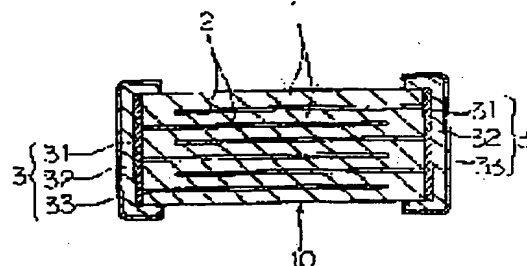
(72)Inventor : KOIZUMI SEIICHI

(54) LAMINATED CERAMIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the insulation resistance of a dielectric ceramic layer and, at the same time, to stably electrically connect internal electrodes composed mainly of Ni layers to external electrodes by preventing the corrosion of the internal electrode layers through a plating solution.

SOLUTION: A laminated ceramic capacitor is provided with a laminated body 10, formed by alternately laminating dielectric ceramic layers 1 and internal electrode layers 2, composed mainly of Ni upon another and external electrodes 3 formed on the end faces of the laminated body. Each external electrode 3 is composed of a baser conductor film 31 connected to half of the internal electrode layers 2, a thermosetting conductive resin film 32 formed on the surface of the conductor film 31, and a surface plated layer 33 formed on the surface of the resin film 32. At the same time, the conductor film 31 is composed mainly of Cu and is set to a thickness of 5-30 μm .



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-54358

(43) 公開日 平成11年(1999) 2月26日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 G 4/12

識別記号

3 5 2

F I

H 0 1 G 4/12

3 5 2

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平9-205022

(22) 出願日

平成9年(1997) 7月30日

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田烏羽殿町 6 番地

(72) 発明者 小泉 成一

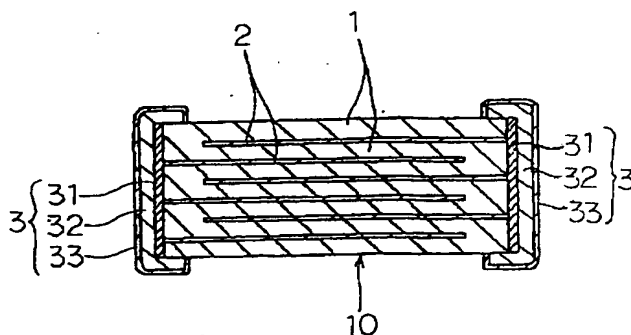
鹿児島県国分市山下町 1 番 4 号 京セラ株式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ

(57) 【要約】

【課題】 誘電体セラミック層の絶縁抵抗を向上できるとともに、メッキ液による内部電極層の腐食を防止して、Ni主成分からなる内部電極層と外部電極との安定した電気的な接続を達成できる積層セラミックコンデンサを提供する。

【解決手段】 誘電体セラミック層1とNiを主成分とする内部電極層2とを交互に積層した積層体10と、該積層体10の端面に形成された外部電極3とを具備した積層セラミックコンデンサであって、外部電極3を、内部電極層2と接続する下地導体膜31と、この下地導体膜31表面に形成された熱硬化性導電性樹脂膜32と、この熱硬化性導電性樹脂膜32の表面に形成された表面メッキ層33とから構成するとともに、下地導体膜31がCuを主成分とし、かつその厚みが5~30 μ mであることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】誘電体セラミック層と Ni を主成分とする内部電極層とを交互に積層した積層体と、該積層体の端面に形成された外部電極とを具備した積層セラミックコンデンサであって、前記外部電極を、前記内部電極層と接続する下地導体膜と、この下地導体膜表面に形成された熱硬化性導電性樹脂膜と、この熱硬化性導電性樹脂膜の表面に形成された表面メッキ層とから構成するとともに、前記下地導体膜が Cu を主成分とし、かつその厚みが 5～30 μm であることを特徴とする積層セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、積層セラミックコンデンサに関し、特に、誘電体セラミック層と Ni を主成分とする内部電極層とを交互に積層した積層体と、この積層体の端面に形成された外部電極とを具備した積層セラミックコンデンサに関する。

【0002】

【従来技術】近年、積層セラミックコンデンサの内部電極層として Ag-Pd 合金が使用されているが、最近の低コスト化に対応するために、内部電極層に Ni、Cu などの卑金属材料が使用されるようになってきている。この Ni、Cu などの卑金属は酸化され易い材料であるため、特に内部電極層の形成工程にあたり、また、形成した後の工程、例えば外部電極の形成工程で、内部電極層の酸化を防止することが重要である。

【0003】例えば、内部電極層の焼成工程、即ち、誘電体セラミック層と内部電極層とが交互に積層された積層成形体の焼成工程や、その後の外部電極の形成工程は、低酸素濃度（ 10^{-8} ～ 10^{-12} atm）雰囲気中で焼成していた。

【0004】内部電極層材料として Ni、Cu などの卑金属材料を用いた積層セラミックコンデンサの外部電極として、従来、特公平 8-4055 号公報には、銅の焼き付け電極からなるものが開示されており、このような積層セラミックコンデンサにおける銅の焼き付け電極は、銅粉末 55～80 重量%と、ガラスフリット 5～20 重量%と、有機ビヒクル 10～30 重量%とからなる銅ペーストを塗布し、還元雰囲気中 800℃、30 分の条件で焼き付けて形成されていた。このような銅の焼き付け電極は、通常剥離等を防止するために 60～100 μm 程度の厚みとされていた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、銅の焼き付け電極の厚みが 60～100 μm と厚いため、脱バインダー処理しても電極中の炭素を完全に飛散できずに残存し、内部電極層の焼成工程や外部電極の形成工程で、上述のような低酸素濃度の焼成処理を行うと誘電体セラミック層が還元され、誘電体セラミック材料の特性

が変化してしまい、特に、コンデンサとしての絶縁抵抗値が低下してしまうという致命的な問題を誘発してしまう。

【0006】絶縁抵抗値が低下してしまった積層セラミックコンデンサにおいては、絶縁抵抗値を回復するために、例えば、高い酸素濃度雰囲気中で熱処理して酸素を補うことが考えられる。例えば、積層体焼結後の熱処理工程である外部電極の焼き付け工程において高い酸素分圧で熱処理を行うと、外部電極を通して内部電極層が酸化され、内部電極層と外部電極との導通がとれず、静電容量がバラツクという問題があった。結局、外部電極は低い酸素分圧で焼き付けせざるを得ず、誘電体セラミック層の絶縁抵抗値の改善は困難であった。

【0007】このような誘電体セラミック層の絶縁抵抗の低下を防止するために、銅の焼き付け電極を薄くすることが考えられる。しかしながら、銅の焼き付け電極の表面には、一般に、ハンダとの濡れ性を向上し、外部電極のハンダ食われを防止するためにメッキ処理が施されるが、このメッキ液が銅の焼き付け電極を透過し、Ni を主成分とする内部電極層を腐食させ、外部電極との電気的な接続が不安定となったり、また内部電極層が腐食して剥離シクラックやデラミネーションが発生するという問題があった。

【0008】また、誘電体セラミック層の絶縁抵抗の低下を防止するために銅ペーストを 800℃以下の低温で焼成しても良いが、この場合には銅の焼き付け電極の緻密化が図れず、メッキ後に内部電極層が腐食し、上記と同様の問題があった。

【0009】本発明は上述の課題に鑑みて案出されたものであり、その目的は、誘電体セラミック層の絶縁抵抗を向上できるとともに、メッキ液による内部電極層の腐食を防止して、Ni 主成分からなる内部電極層と外部電極との安定した電気的な接続を達成できる積層セラミックコンデンサを提供することである。

【0010】

【課題を解決しようとする手段】本発明の積層セラミックコンデンサは、誘電体セラミック層と Ni を主成分とする内部電極層とを交互に積層した積層体と、該積層体の端面に形成された外部電極とを具備した積層セラミックコンデンサであって、前記外部電極を、前記内部電極層と接続する下地導体膜と、この下地導体膜表面に形成された熱硬化性導電性樹脂膜と、この熱硬化性導電性樹脂膜の表面に形成された表面メッキ層とから構成するとともに、前記下地導体膜が Cu を主成分とし、かつその厚みが 5～30 μm であることを特徴とする。

【0011】

【作用】本発明によれば、Cu を主成分とする下地導体膜の厚みを 5～30 μm とし、従来よりも薄くしたため、脱バインダー処理において有機溶媒を完全に飛散させることができ、焼成時に誘電体セラミック層を還元す

ることがなく、これにより絶縁抵抗が低下することがない。

【0012】また、この下地導体膜表面に熱硬化性導電性樹脂膜を形成し、この熱硬化性導電性樹脂膜の表面に表面メッキ層を形成したので、下地導体膜の厚みが5～30 μm と薄い場合であっても、メッキ液が熱硬化性導電性樹脂膜により遮断され、内部電極層を腐食させることがない。これにより、外部電極との電気的な接続が不安定となったり、また内部電極層が腐食することによるクラックやデラミネーションの発生もない。また、表面メッキ層により、熱硬化性導電性樹脂膜のハンダ濡れ性を補い、外部電極のハンダ食われを防止することができる。

【0013】しかも、Niを主成分とする内部電極層と、Cuを主成分とする下地導体膜との接合部分が、NiとCuの合金を形成し、内部電極層と下地導体膜とが一体化し、内部電極層と外部電極とを強固に接続できる。

【0014】さらに、本発明によれば、Niを主成分とする内部電極層と誘電体セラミック層とが交互に積層した焼成前の積層成形体が、内部電極層が酸化されない程度の低い酸素分圧中で焼成処理されて、その後、絶縁抵抗値の回復のために、高い酸素濃度雰囲気中で熱処理し、Cuを主成分とする下地導体膜を厚み5～30 μm で積層焼結体の端面に形成し、下地導体膜が酸化されない程度の酸素分圧で焼成する。

【0015】その後熱硬化性導電性樹脂膜を大気雰囲気中などで150℃以上の熱硬化処理を行って形成するが、外部電極を構成する熱硬化性導電性樹脂膜を大気中において低温で形成できるため、内部電極層および下地導体膜を酸化させることなく、絶縁抵抗値の劣化及び信頼性の劣化が発生しない。

【0016】これにより、絶縁抵抗値の低下を改善しても、内部電極層と外部電極との接合信頼性は高く、しかも、内部電極層にNiを用いた低コストの積層セラミックコンデンサを得ることができる。

【0017】尚、従来、特開平8-107039号公報には、内部電極層がAg-Pdからなり、外部電極が、内部電極層に接続されるAg、Ag-Pd、Cuからなる下地導体膜と、この下地導体膜に形成されたNi、Cuメッキ膜と、このメッキ膜に形成された導電性樹脂膜と、この導電性樹脂膜の上面に形成されたSn、Sn-Pbのメッキ膜とから構成した積層コンデンサが開示されている。

【0018】しかしながら、Ag-Pdからなる内部電極層を用いていたため、上記したようにコスト高になるという問題があったが、本願発明では、内部電極層がNiを主成分とするため低コストとできる。

【0019】

【発明の実施の形態】図1は本発明の積層セラミックコ

ンデンサを示すもので、図において、符号1は誘電体セラミック層、2はNiを主成分とする内部電極層、3は外部電極を示している。この積層セラミックコンデンサは、誘電体セラミック層1とNiを主成分とする内部電極層2とを交互に積層して積層体10を形成し、この積層体10の両端面に外部電極3を形成して構成されている。

【0020】外部電極3は、積層体10の端面側からCuを主成分とする下地導体膜31、熱硬化性導電性樹脂膜32、表面メッキ層33とから構成されている。

【0021】誘電体セラミック層1は、チタン酸バリウムやチタン酸バリウムに酸化イトリウム、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウムなどを含有する誘電体磁器であり、焼成後の1層当たりの膜厚は10～30 μm が望ましい。

【0022】内部電極層2は、Niを主成分とし、概略矩形状の導体膜であり、上から第1層目、第3層目、第5層目・・・の奇数層の内部電極層2は、その一端が積層体10の一方端面に延出しており、上から第2層目、第4層目、第6層目・・・の内部電極層2は、その一端が積層体10の他方端面に延出している。

【0023】Niを主成分とする内部電極層2とは、Niのみからなる場合も含まれる概念であるが、Niの酸化物を含有することがあり、さらに、例えば、Cr、Co、Cu等の金属や化合物等が意図的に、また不純物として含まれる場合を含め、これらを総称して本発明では、Niを主成分とする内部電極層2という。

【0024】外部電極3の一部を構成する下地導体膜31は、焼成後の積層体10の両端面に、Cuを主成分とする導電性ペーストの塗布及び積層体10への焼き付けによって形成されるものである。

【0025】Cuを主成分とする下地導体膜31とは、Cuのみからなるものも含まれる概念であるが、Cuの酸化物を含有することがあり、さらに、例えば、Cr、Co、Ni、Zn等の金属や化合物等が意図的に、また不純物として含まれる場合を含め、これらを総称してCuを主成分とする下地導体膜31という。このCuを主成分とする下地導体膜31とNiを主成分とする内部電極層2との接合部は、NiとCuの合金が形成されている。

【0026】そして、下地導体膜31の厚みは5～30 μm とされている。下地導体膜31の厚みが5 μm よりも薄い場合には、内部電極層との接合が不安定となるため容量バラツキが大きくなり、30 μm よりも厚くなると、脱バインダー処理しても電極中の炭素を完全に飛散できずに残存し、内部電極層2の焼成工程や外部電極3の形成工程で、上述のような低酸素濃度の焼成処理を行うと誘電体セラミック層1が還元され、コンデンサとしての絶縁抵抗値が低下し、信頼性不良の発生が多くなるからである。下地導体膜31の厚みは容量、信頼性とい

う点から20~30 μ mが望ましい。

【0027】また、熱硬化性導電性樹脂膜32は、例えばAg系(Ag単体またはAg合金)導体材料を含むエポキシ系などの熱硬化性樹脂で構成され、このような樹脂ペーストを下地導体膜31表面に塗布し、大気雰囲気中で150~300℃で熱処理されて形成される。

【0028】さらに、表面メッキ層33は、熱硬化性導電性樹脂膜32の表面に順次形成された、例えばNiメッキ層、Snメッキ層、半田メッキ層などからなる積層構造であり、熱硬化性導電性樹脂膜32の半田濡れ性を補い、また、外部電極3の半田食われを防止するものである。

【0029】以上のように、本発明の積層セラミックコンデンサでは、先ず、内部電極層2としてNiを主成分とする材料を用いているため、積層セラミックコンデンサ全体として低コスト化が図れる。しかも、外部電極3を構成し、且つ内部電極層2と接続する下地導体膜31に、Cuを主成分とする材料を用いているため、下地導体膜31を焼き付けると、内部電極層2と下地導体膜31との接合部は、NiとCuの合金を形成し、内部電極層2と外部電極3とが一体化し、内部電極層2と下地導体膜31との接続を強固なものとすることができる。

【0030】また、本発明によれば、Cuを主成分とする下地導体膜31の厚みを5~30 μ mとし、従来よりも薄くしたため、脱バインダー処理において有機溶媒を完全に飛散させることができ、焼成時に誘電体セラミック層1を還元することがなく、これにより絶縁抵抗が低下することがない。

【0031】さらにまた、その後の熱処理である外部電極3の熱硬化性導電性樹脂膜32の形成工程では、150℃以上、例えば、150~300℃程度の熱処理が施されるが、外部電極3の形成を大気雰囲気中で行うことができ、内部電極層2と下地導体膜31との安定な接合が何等影響されることがない。

【0032】また、この下地導体膜31表面に熱硬化性導電性樹脂膜32を形成し、この熱硬化性導電性樹脂膜32の表面に表面メッキ層33を形成したので、下地導体膜31の厚みが5~30 μ mと薄い場合であっても、メッキ液が熱硬化性導電性樹脂膜32により遮断され、下地導体膜31を介して内部電極層2を腐食させることがない。これにより、外部電極3との電気的な接続が不安定となったり、また内部電極層2が腐食することによるクラックやデラミネーションの発生もない。

【0033】また、表面メッキ層33により、熱硬化性導電性樹脂膜32のハンダ濡れ性を補い、外部電極3のハンダ食われを防止することができる。

【0034】本発明の積層セラミックコンデンサでは、内部電極層と外部電極の下地導体膜との接合が非常に安定し、セラミック焼成工程中で生じた酸素不足を解消する酸化処理を施しても両者の接合部分の酸化が進行する

ことがなく、しかも、外部電極を構成する導電性樹脂膜を低温の大気中で形成できるため、熱履歴的な変動がなく、絶縁抵抗値の劣化及び信頼性の劣化が発生しない、安価な積層セラミックコンデンサとなる。

【0035】次に、本発明の積層セラミックコンデンサの製法の一例を簡単に説明すると、先ず、誘電体磁器組成物に有機系粘結剤と媒体から成るバイダーを添加・攪拌してセラミック泥漿を調製した後、得られたセラミック泥漿を用いて、ドクターブレード法により誘電体セラミックグリーンシートを形成する。

【0036】得られた誘電体セラミックグリーンシート上に、Niを主成分とする内部電極層用ペーストを用いて、内部電極層2となる導体膜を所定形状にスクリーン印刷する。その後、上述の誘電体セラミックと同一のセラミックペーストを塗布し、誘電体セラミック層1となる誘電体層を形成し、さらに、内部電極層2となる導体膜、誘電体層を交互に塗布する。このようにして、それぞれ100回繰り返す。こうして得られた積層成形体を、所定寸法に切断してグリーンチップ(焼成前の積層体)を作製した。

【0037】その積層成形体を脱バインダー処理、焼成を行い、続いて大気雰囲気中において再酸化処理をする。これにより、誘電体セラミック層1での絶縁抵抗値の低下を回復できる。

【0038】次に、焼成した積層体10の端面にCuを主成分とするペーストを塗布し、焼成し、下地導体膜31を形成した後、Agを含むエポキシ樹脂からなる導電性Agペーストを、下地導体膜31上に塗布し、硬化させて熱硬化性導電性樹脂膜を形成し、その後、熱硬化性導電性樹脂膜の表面に表面メッキ層を施すことにより、本発明の積層セラミックコンデンサが得られる。

【0039】

【実施例】先ずチタン酸バリウム(BaTiO_3)と、このチタン酸バリウム100重量部に対して酸化イットリウム(Y_2O_3)を1重量部、酸化マグネシウム(MgO)を0.2重量部、炭酸マンガン(MnCO_3)0.1重量部、 Li_2O と SiO_2 とからなるガラス成分(LiとSiのモル比が1:1)を0.5重量部含有する誘電体磁器組成物に、有機系粘結剤と媒体から成るバイダーを添加・攪拌してセラミック泥漿を調製した後、得られたセラミック泥漿を脱泡し、ドクターブレード法により厚さ7 μ mの誘電体セラミックグリーンシートを形成した。

【0040】得られた誘電体セラミックグリーンシート上に、Ni粉末と、エチルセルロース、テルビネオールとからなる内部電極層用ペーストを用いてスクリーン印刷した。その後、上述の誘電体セラミックグリーンシートと同一の組成のセラミックペーストを作製塗布し、誘電体層成形体を形成し、さらに、内部電極層用ペーストとセラミックペーストの塗布を交互にそれぞれ100回

繰り返した。こうして得られた積層成形体を、所定寸法（2125型）に切断してグリーンチップ（焼成前の積層成形体）を作製した。

【0041】その積層成形体を大気中で400℃にて脱バインダー処理を行い、その後1250℃（ PO_2 10⁻¹¹ atm）で2時間焼成し、続いて大気雰囲気中800℃で再酸化処理をした。

【0042】次に、焼成した積層体10の端面にロール転写法により、Cu粉末と、アクリル樹脂とからなるペーストを塗布し、酸素濃度2ppmで900℃で焼成し、表1に示すような厚みの下地導体膜31を形成し、Agを含むエポキシ樹脂からなる導電性Agペーストを、下地導体膜31上に塗布し、200℃、30分で硬化させ、厚みが60μmの熱硬化性導電性樹脂膜を形成した。

【0043】その後、熱硬化性導電性樹脂膜32の表面

に、厚み2μmのNiメッキおよび厚み2μmのSnメッキを施すことにより、本発明の積層セラミックコンデンサを作製した。得られたコンデンサの誘電体セラミック層の積層数100層、一層当たりの厚みは5μmであった。

【0044】得られた積層セラミックコンデンサは、LCRメーター4284Aを用い、周波数1KHz入力信号1Vrmsにて静電容量、誘電損失DFを測定した。また、電圧16Vを印加して1分間後の絶縁抵抗IRを測定した。さらに、150℃において40Vを印加する高温負荷試験を300個行い、40時間以内に故障した個数を測定し、信頼性不良率を算出した。また、250℃の半田槽に試料を浸漬しクラックの発生状態を観察した。その結果を表1に示す。

【0045】

【表1】

試料 No.	下地導体膜 厚み μm	静電容量 (nF)	DF (%)	IR GΩ	信頼性不良率 %	クラック 発生率%
1	5	725	3.5	22	0	0
2	10	738	2.9	22	0	0
3	20	735	3.0	22	0	0
4	30	745	2.9	22	0	0
*5	40	748	3.0	15	5	12
*6	60	745	3.9	2	28	35

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

【0046】表1によれば、本発明の試料では、Cuからなる下地導体膜の厚みが5～30μmの場合には、焼成中にカーボンにより絶縁抵抗を劣化させることはなく、絶縁抵抗が22GΩ以上となり、信頼性不良率およびクラックも発生しないことが判る。Cuからなる下地導体膜の厚みが30μmよりも厚くなると、絶縁抵抗が劣化し、信頼性不良率およびクラックの発生率も高くなることが判る。

【0047】本発明者は、導電性樹脂膜を形成することなく、下地導体膜の表面に表面メッキ層を形成する以外は、上記と同様にして積層セラミックコンデンサを作製したところ、静電容量が720nF、誘電損失3.4%、絶縁抵抗IRが18GΩ、信頼性不良率15%、クラックの発生率が100%であった。

【0048】

【発明の効果】以上のように、Cuを主成分とする下地導体膜の厚みを5～30μmとし、従来よりも薄くしたため、脱バインダー処理において有機溶媒を完全に飛散させることができ、焼成時に誘電体セラミック層を還元することがなく、これにより絶縁抵抗が低下することがない。

【0049】また、この下地導体膜表面に熱硬化性導電

性樹脂膜を形成し、この熱硬化性導電性樹脂膜の表面に表面メッキ層を形成したので、下地導体膜の厚みが5～30μmと薄い場合であっても、メッキ液が熱硬化性導電性樹脂膜により遮断され、下地導体膜を介して内部電極層を腐食させることがない。

【0050】さらに、熱硬化性導電性樹脂膜を大気雰囲気中などで150℃以上の熱硬化処理を行って形成できるが、外部電極を構成する熱硬化性導電性樹脂膜を大気中において低温で形成できるため、内部電極層および下地導体膜を酸化させることなく、絶縁抵抗値の劣化及び信頼性の劣化が発生しない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の積層セラミックコンデンサの断面図である。

【符号の説明】

- 1・・・誘電体セラミック層
- 2・・・内部電極層
- 3・・・外部電極
- 10・・・積層体
- 31・・・下地導体膜
- 32・・・熱硬化性導電性樹脂膜
- 33・・・表面メッキ層

【図 1】

